

SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

FMMT555

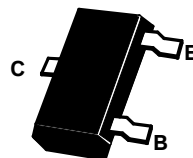
ISSUE 4 – AUGUST 2003

FEATURES

- * 150 Volt V_{CEO}
- * 1 Amp continuous current

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT455

PARTMARKING DETAIL – 555



SOT23

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-160	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-150	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-2	A
Continuous Collector Current	I_C	-1	A
Base Current	I_B	-200	mA
Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

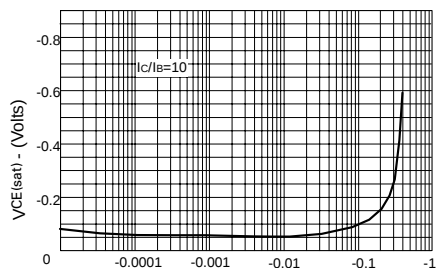
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-160		V	$I_C = -10\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-150		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5		V	$I_E = -10\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		-0.1 -10	μA nA	$V_{CB} = -140\text{V}$ $V_{CB} = -140\text{V}, T_{amb} = 100^\circ\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		-0.1	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.3	V	$I_C = -100\text{mA}, I_B = -10\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-1	V	$I_C = -100\text{mA}, I_B = -10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-on Voltage	$V_{BE(on)}$		-1	V	$I_C = -100\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	50 50	300		$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$ $I_C = -300\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	100		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		10	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $> 2\%$
Spice parameter data is available upon request for this device

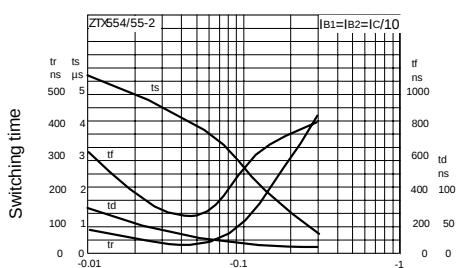


TYPICAL CHARACTERISTICS



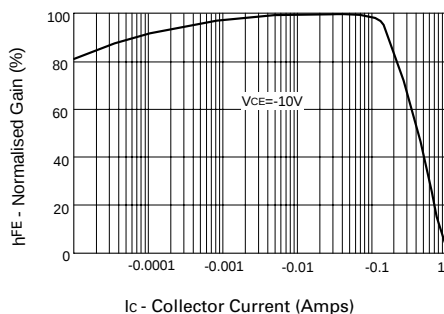
I_C - Collector Current (Amps)

$V_{CE(sat)}$ v I_C



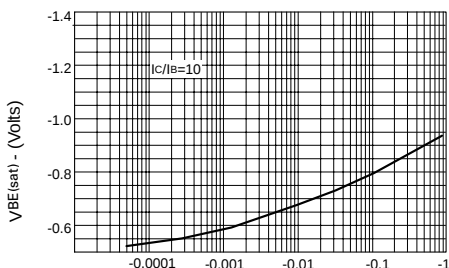
I_C - Collector Current (Amps)

Switching Speeds



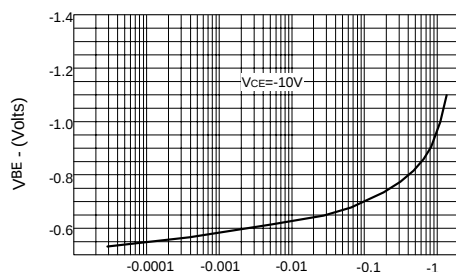
I_C - Collector Current (Amps)

h_{FE} v I_C



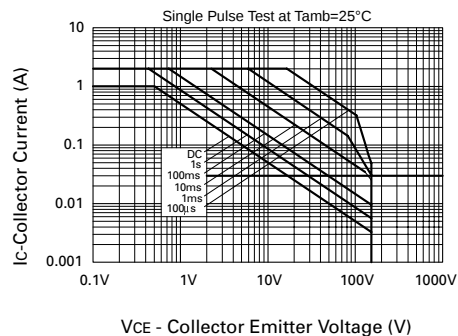
I_C - Collector Current (Amps)

$V_{BE(sat)}$ v I_C



I_C - Collector Current (Amps)

$V_{BE(on)}$ v I_C



V_{CE} - Collector Emitter Voltage (V)

Safe Operating Area

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9